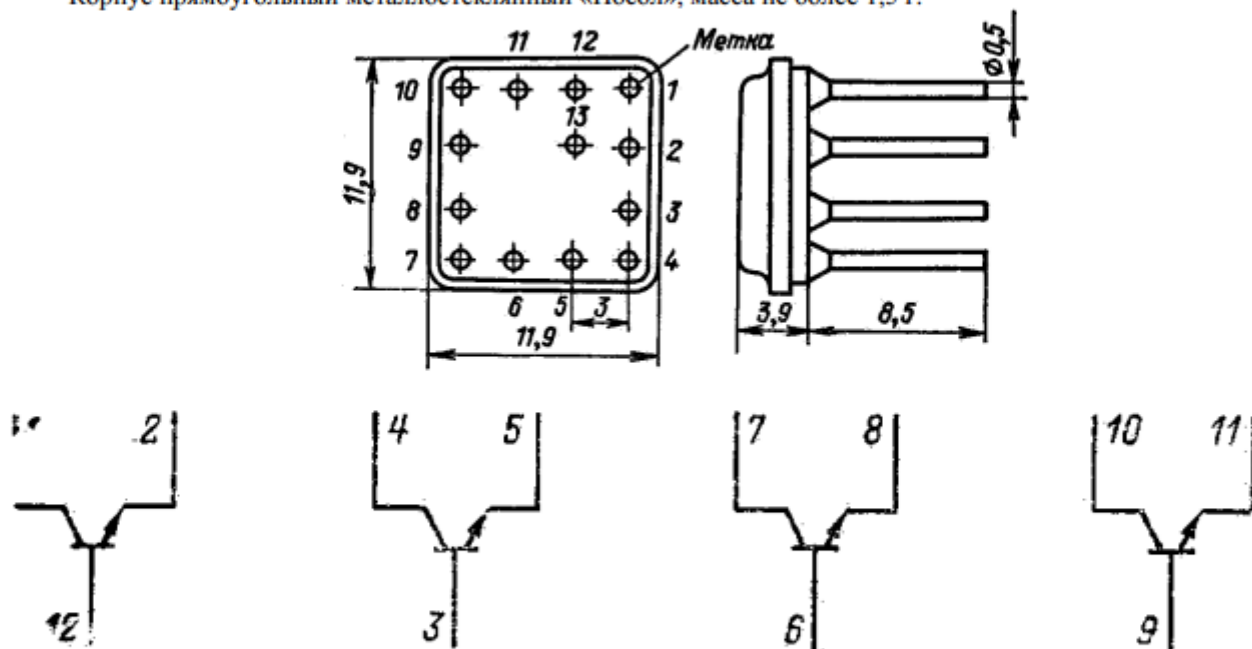


## 217HT1 (2HT171), 217HT2 (2HT172), 217HT3 (2HT173), K217HT1 (K2HT171), K217HT2 (K2HT172), K217HT3 (K2HT173)

Микросхемы представляют собой сборку из четырех p-p-n транзисторов.  
Корпус прямоугольный металлоглазый «Посол», масса не более 1,5 г.



### Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	< 0,33 В
Обратный ток коллектора	< 1 мкА
Время рассасывания	< 25 нс
Коэффициент передачи по току	
(K)217HT1	30...90
(K)217HT2	50...150
(K)217HT3	70...280

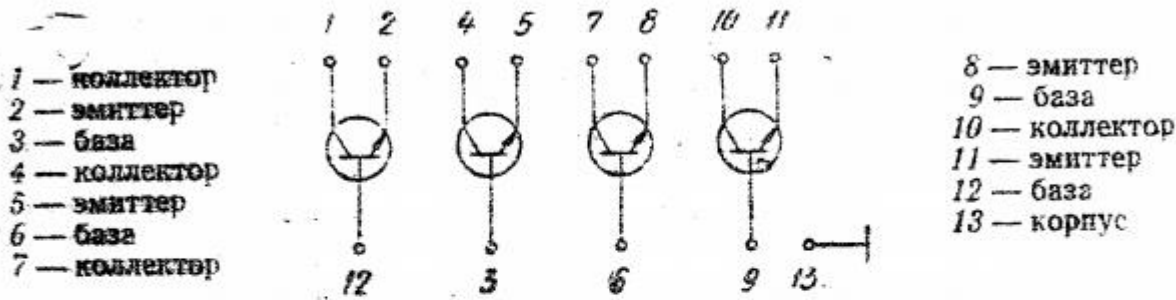
### Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-эмиттер	10 В
Ток коллектора	20 мА
Рассеиваемая мощность одного транзистора	< 20 мВт
Температура окружающей среды	
217HT1,2,3	-60...+70°C
K217HT1,2,3	-30...+70°C
Многokратное циклическое изменение температуры (217HT1,2,3)	-60...+70°C
Относительная влажность воздуха при +40°C	до 98%
Атмосферное давление (217HT1,2,3)	6,7x10 <sup>2</sup> ...3x10 <sup>5</sup> Па
Вибрационные нагрузки	
217HT1,2,3 (5-5000 Гц)	до 40 g
K217HT1,2,3 (5-600 Гц)	до 5 g
Многokратные удары с ускорением	
217HT1,2,3	до 150 g
K217HT1,2,3	до 15 g
Линейные нагрузки с ускорением	
217HT1,2,3	до 150 g
K217HT1,2,3	до 25 g
Одиночные удары с ускорением (217HT1,2,3)	до 1000 g

# НАБОР ТРАНЗИСТОРОВ

217НТ1  
217НТ2  
217НТ3

## ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре  $25 \pm 5^\circ \text{C}$ )

Обратный ток коллектора при $U_K = 7 \text{ В}$ . . . . .	не более 1 мкА
Напряжение коллектор—эмиттер в режиме насыщения* . . . . .	не более 0,33 В
Напряжение база—эмиттер в режиме насыщения при $I_K = 10 \text{ мА}$ ; $I_B = 1 \text{ мА}$ . . . . .	не более 1 В
Напряжение обертывания при $U_K = 10 \text{ мА}$ . . . . .	не менее 0,55 В
Статический коэффициент передачи тока при $I_B = -10 \text{ мА}$ для микросхем:	
217НТ1 . . . . .	30—90
217НТ2 . . . . .	70—150
217НТ3 . . . . .	70—280
Время рассасывания при $I_K = 10 \text{ мА}$ ; $I_{Б1} = 2 \text{ мА}$ ; $I_{Б2} = 1 \text{ мА}$ . . . . .	не более 25 нс

## НАДЕЖНОСТЬ

Электрические параметры в течение минимальной наработки:

обратный ток коллектора при $U_K = 7 \text{ В}$ . . . . .	не более 5 мкА
напряжение коллектор—эмиттер в режиме насыщения* . . . . .	не более 0,37 В

\* При  $I_K = 10 \text{ мА}$ ,  
 $I_B = 1 \text{ мА}$  — для 217НТ1;  
 $I_B = 0,6 \text{ мА}$  — для 217НТ2;  
 $I_B = 0,43 \text{ мА}$  — для 217НТ3.

217HT1  
217HT2  
217HT3

НАБОР ТРАНЗИСТОРОВ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная рассеиваемая мощность микросхемы  
при работе:

одного транзистора . . . . .	20 мВт
двух транзисторов . . . . .	40 мВт
трех транзисторов . . . . .	60 мВт
четырёх транзисторов . . . . .	80 мВт
Максимальное напряжение коллектор—база . . . . .	10 В
Максимальное напряжение коллектор—эмиттер . . . . .	10 В
Максимальное напряжение эмиттер—база . . . . .	3,5 В
Максимальный ток коллектора . . . . .	20 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{имп} \leq 10$ мкс, $\tau_{ф} \leq 100$ нс, $\frac{T}{t} = 10$ . . . . .	45 мА